

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-061

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目

● **投资金额：**项目总投资计划约 22.62 亿元

● **本次交易未达到股东会审议标准**

● 本项目建设周期约 60 个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，本项目预计每年投入金额约 3.5 亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本项目建设周期较长，在项目实施过程中可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在一定的不确定性。未来随着新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有

限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内建设“年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目”（以下称“本项目”），本项目计划总投资 22.62 亿元，其中固定资产投资 21.96 亿元。本项目建设周期约 60 个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，本项目预计每年投入金额约 3.5 亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节。

金瑞泓微电子聚焦 12 英寸重掺硅片产品的生产，制备出的 12 英寸重掺系列外延片满足高端功率器件需求，终端应用于 AI 服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域，市场需求广阔。金瑞泓微电子现有重掺系列硅片产能爬坡迅速，目前已接近满产，为进一步满足市场需求，尤其是高端功率器件市场急需重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品需求，金瑞泓微电子本次在现有厂房内建设“年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目”，系在金瑞泓微电子现有厂房内实施的扩产项目，可与现有“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”形成上下游配套。本项目实施后，公司将实现新增年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片的产能规模，提高公司重掺系列硅片生产能力，优化公司产品结构，提升产品丰富度，同时可进一步满足集成电路市场需求，提升公司综合竞争力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<div><input type="checkbox"/>新设公司</div> <div><input type="checkbox"/>增资现有公司（<input type="checkbox"/>同比例 <input type="checkbox"/>非同比例）</div> <div><div>一增资前标的公司类型：<input type="checkbox"/>全资子公司 <input type="checkbox"/>控股子公司</div><div><input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>未持股公司</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>投资新项目</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
投资标的名称	年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目
投资金额	<div><input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：<u>226,200</u></div> <div><input type="checkbox"/> 尚未确定</div>

出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：自筹资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<投资协议书>的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）公司与衢州智造新城管理委员会不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目利用金瑞泓微电子现有厂房进行局部改造，利用公司已掌握的成熟的 12 英寸硅片成套工艺和技术，通过购置单晶炉、抛光机等一批国内外先进设备，形成年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片的生产能力，满足功率器件衬底材料及集成电路市场需求。

（二）投资标的的信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目
项目主要内容	通过购置单晶炉、抛光机等一批国内外先进设备，形成年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片的生产能力
建设地点	衢州智造新城东港片区盘龙南路 52 号（金瑞泓微电子现有厂房内）
项目总投资金额（万元）	226,200

上市公司投资金额（万元）	226, 200
项目建设期（月）	60
预计开工时间	2025/12/31
预计投资收益率	7. 76%
是否属于主营业务范围	√ 是 □ 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由金瑞泓微电子负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本对外投资项目已经完成项目可行性研究报告的编制工作，已经完成公司董事会决策程序，金瑞泓微电子与衢州智造新城管理委员会已签署《投资协议书》。

（4）项目市场定位及可行性分析

金瑞泓微电子已掌握 12 英寸硅片成套工艺核心技术。本项目将采用金瑞泓自主开发的重掺杂直拉硅单晶的制备技术、微量掺锗直拉硅单晶技术和低缺陷掺氮直拉硅单晶技术等最重要的生产工艺。金瑞泓作为专注于硅材料生产制造的企业，依靠产业链上下游一体化等优势，发展成为我国硅材料生产的龙头企业，占有相当比例的市场份额，已具备 12 英寸硅片的大规模生产技术基础。项目实施后，公司将实现新增年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片的产能规模，有利于开发和制备当前高端功率器件市场急需的重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，优化产品结构，提升产品丰富度，加快技术迭代，同时可进一步满足集成电路市场需求，巩固市场头部地位，提升综合竞争力，提高我国半导体硅片的自主化水平，匹配国内晶圆厂发展，提升国内半导体产业链竞争力。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及自筹资金，不属于募集资金。

三、《投资协议》的主要内容

甲方：衢州智造新城管理委员会

乙方：金瑞泓微电子（衢州）有限公司

（一）投资项目情况

1.1 项目名称和内容：年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目（以下简称“本项目”）。

1.2 项目投资：本项目总投资计划约 22.62 亿元（人民币，下同），固定资产投资计划约

21.96 亿元。

1.3 项目建设周期：本项目计划于 2026 年 2 月底前开工建设，于 2029 年 6 月底前投产。

（二）项目用地

2.1 本项目选址位于衢州智造新城东港片区盘龙南路 52 号乙方原有厂房内，厂房使用面积约 19000 平方米。

（三）甲方承诺

3.1 甲方将建立专门项目建设服务领导小组，统筹服务项目建设相关事项，协调解决项目建设过程中的重大问题，助力项目建设快速、高效、有序推进。

3.2 甲方应积极主动协助乙方办理项目相关的各项手续，所需协助事项乙方应提前通知甲方。

3.3 甲方应依法依规将本协议约定给予乙方的各项支持及相关政策落实到位。

（四）乙方承诺

4.1 本项目的投资建设情况应满足以下要求：

①自本项目协议签订之日起 5 个月内开工建设（因不可归责于乙方的原因造成逾期的，经甲方书面确认后可顺延）。

②自本项目协议签订之日起 40 个月内投产（因不可归责于乙方的原因造成逾期的，经甲方书面确认后可顺延，下同）。本协议项下投产时间以经现场核实后乙方本项目第一批产品发货记录为准，下同。

③本项目建设须依法依规办理项目备案、施工许可证等相关手续。

4.2 乙方应按甲方要求报送财务、税务、统计等资料。乙方与其关联方之间的业务往来，应按独立交易原则进行财务核算和申报纳税，不符合独立交易原则的，甲方所在地税务机关有权按照税收反避税相关规定进行纳税调整。

4.3 乙方法人在项目建设过程中应主动向甲方所在地税务机关报告项目建设信息，督促施工单位按照项目所在地税务机关的管理要求履行报备和预缴税款等义务，在支付施工款项前须取得施工单位在项目所在地预缴税款的合法凭证等。

4.4 乙方必须严格按照本协议项下的建设项目内容使用场地，不得擅自改变项目场地用途和本协议项下的实际使用目的。

4.5 乙方应按照生态环境部门、应急管理部门的要求落实环保、安全生产措施，做好环保

设施、安全生产设施与项目同步设计、同步施工、同时运营使用，并主动接受生态环境部门、应急管理部門的监管，切实做好三废的收集和处置，确保污染物达标排放，安全生产符合相应条件。同时项目公司还应按照发改委、人社局、资源规划局、住建局、卫健委、市场监管局、消防救援支队等部门要求落实各项行业管理措施，随时接受监督管理。

4.6 自本协议约定的项目投产期限届满（即自本项目协议签订之日起满 40 个月）之日起算的 10 个完整年度（含）作为本项目的统算考核期，统算考核期内乙方对甲方产生的实际贡献总额（乙方已用于或拟用于乙方与甲方签署并生效的其他投资协议项下考核的部分实际贡献除外）须不低于乙方基于本协议第 5.1 条项下已实际获取的资金总额。

五、政策支持（省略）

六、违约责任

6.1 乙方应按本协议第 4.1 条约定的时限保证本项目的开工建设。若因不可归责于甲方的原因导致项目未能按前述约定时限开工的，甲方有权暂停本协议项下政策支持，并督促乙方开工。乙方逾期 6 个月仍未能开工建设的，甲方有权解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等。若甲方解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等的，则：①甲方同时有权立即停止给予本协议第五条项下的政策支持；②乙方产生的各项损失自行承担，甲方不作赔偿或补偿。

6.2 乙方应按本协议第 4.1 条约定的时限保证本项目投产。若因不可归责于甲方的原因导致乙方项目未能按时投产的，则甲方有权暂停本协议项下的政策支持。若乙方确有客观原因导致未能按时投产，则经甲方书面同意可给予一个不超过 12 个月的宽限期。若宽限期届满乙方仍未投产或甲方不同意给予宽限期的，则甲方有权停止本项目项下的政策支持。

6.3 若乙方未经甲方书面同意擅自改变本协议项下的建设项目内容的，一经查实，则甲方有权提请土地主管部门依法依约处置，同时甲方还有权解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等。若甲方解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等的，则：①甲方同时有权立即停止给予本协议第五条项下的政策支持；②乙方应立即返还本项目已经实际享受的政策支持项下所获取的资金（但本协议明确约定不适用违约返还的除外），并向甲方支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算的资金利息；③乙方产生的各项损失自行承担，甲方不作赔偿或补偿。

6.4 若乙方未能做到本协议第 4.6 条项下承诺，在自本协议约定的项目投产期限届满（自本项目协议签订之日起满 40 个月）之日起算的 10 个完整年度（含）的统算考核期内，对甲方

实际贡献总额低于乙方基于本协议第 5.1 条项下已实际获取的资金总额的，不足的差额部分，由乙方在上述 10 个完整年度考核期届满之日起 90 个工作日内全部返还给甲方。

七、其他（部分省略）

双方应当对本协议及本协议的全部内容保守秘密，其中任一方未经另一方书面同意，不得向本协议主体以外的第三方披露本协议及本协议项下任何内容。双方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的工作人员披露本协议内容，但同时须指示其工作人员遵守本条规定的保密义务。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

四、对外投资对上市公司的影响

金瑞泓微电子本次投资“年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片项目”系在金瑞泓微电子现有厂房内实施的扩产项目。本项目可与现有“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”形成上下游配套，制备出的 12 英寸重掺系列外延片，满足高端功率器件需求，应用于 AI 服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等，符合公司的发展战略和长远规划。

本项目实施后，公司将实现新增年产 180 万片 12 英寸重掺衬底片的产能规模，有利于开发和制备当前高端功率器件市场急需的重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，可显著提高公司重掺系列硅片生产能力，优化产品结构，提升产品丰富度，巩固市场头部地位，提升综合竞争力。有利于提升上市公司持续经营能力，符合公司全体股东的利益。

项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，本项目将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，预计每年投入金额约 3.5 亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。由于项目建设尚需一定的时间周期，预计对公司 2025 年度的经营业绩不会构成重大影响。

五、对外投资的风险提示

本项目建设周期较长，在项目实施过程中可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在一定的不确定性。

当前新能源汽车、AI 服务器、储能等新兴产业飞速发展，高端功率器件市场急需重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，但相关产业的发展受到宏观经济、政策支持、市场需求等因素的影响，可能会阶段性不达预期。针对前述风险，金瑞泓微电子将充

分发挥 12 英寸重掺硅片技术优势和市场领先优势，不断开拓客户群体，分阶段扩大产能，持续提升市场份额，保持市场竞争力。

未来随着上述新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。金瑞泓作为专注于硅材料生产制造的企业，将持续依靠产业链上下游一体化等优势，不断加大研发投入，开发新产品，提高产品附加值；同时加强运营管理，降低运营成本，保障产品质量，提升产品效益。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日